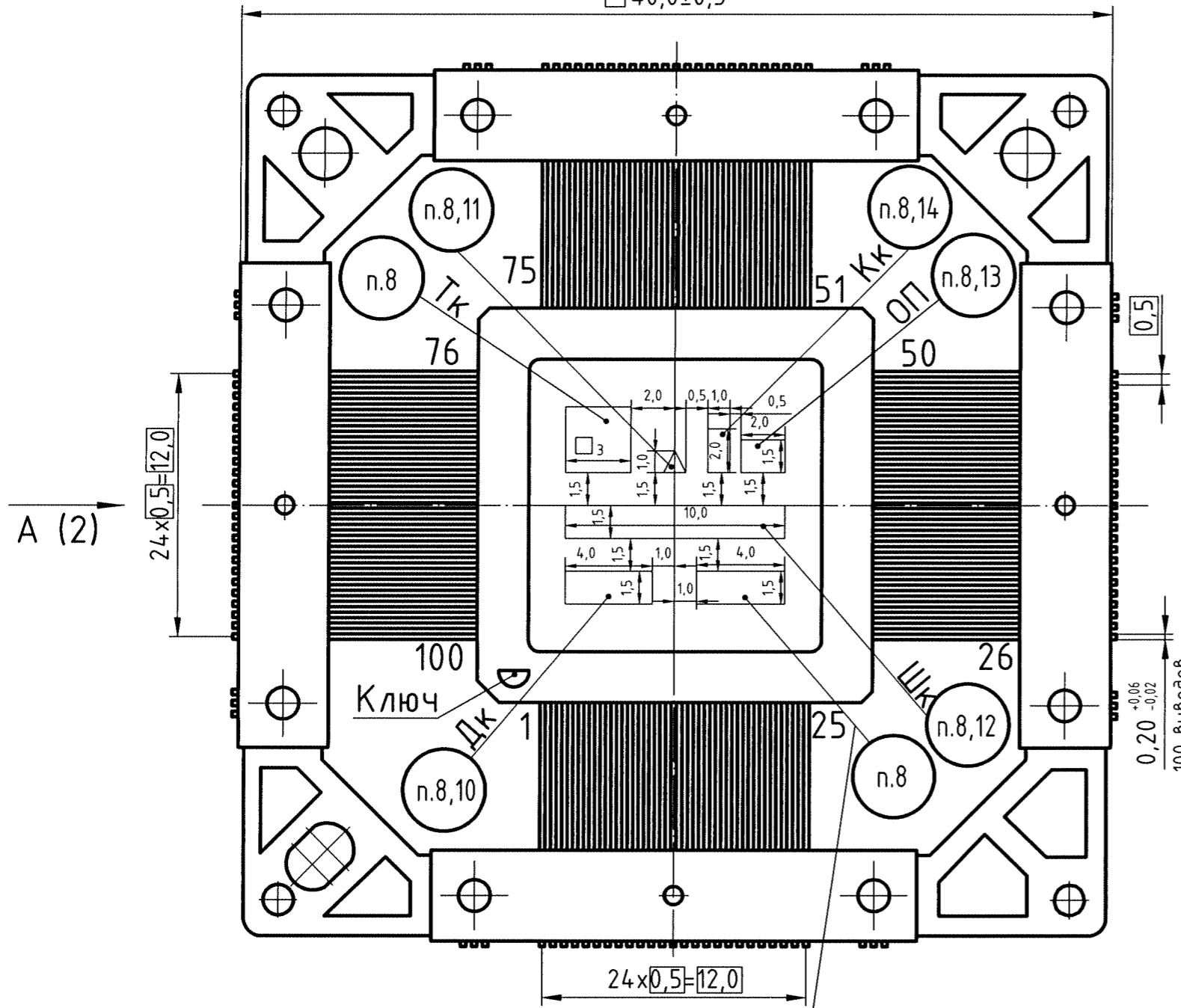


□40,0±0,5



Регистрационный номер карты заказа

Таблица 1 - Модификация

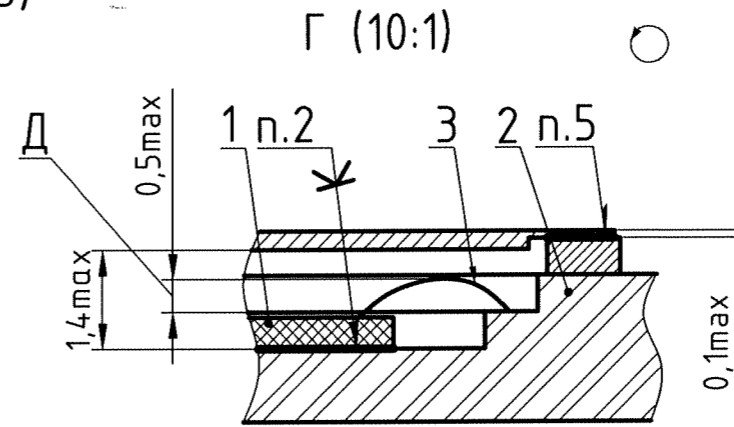
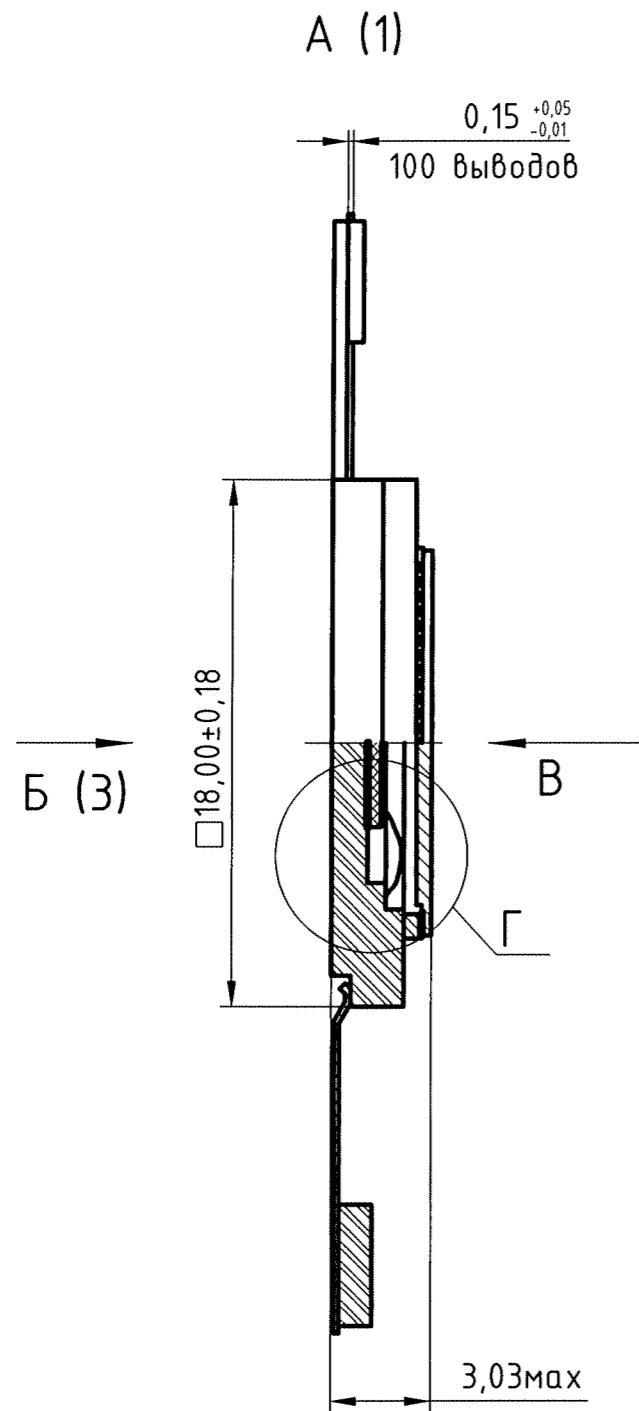
Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
ГАВЛ.431268.015	5529ТР044	МК 4247.100-3	5529ТР044	max 5,5 г	1
-01	5529ТР044А	МК 4239.68-2	5529ТР044А	max 4,0 г	2

1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3}$ Па*см³/с.
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида ГАВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно основному виду. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83. Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
9. С обратной стороны маркировать согласно виду Б для микросхемы 5529ТР044, виду Ж для 5529ТР044А.
10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
11. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
12. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
14. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
15. Нумерация выводов приведена условно.
16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР044 соответствует данным этикетки ГАВЛ.431268.015ЭТ, 5529ТР044А - ГАВЛ.431268.015-01ЭТ.
17. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

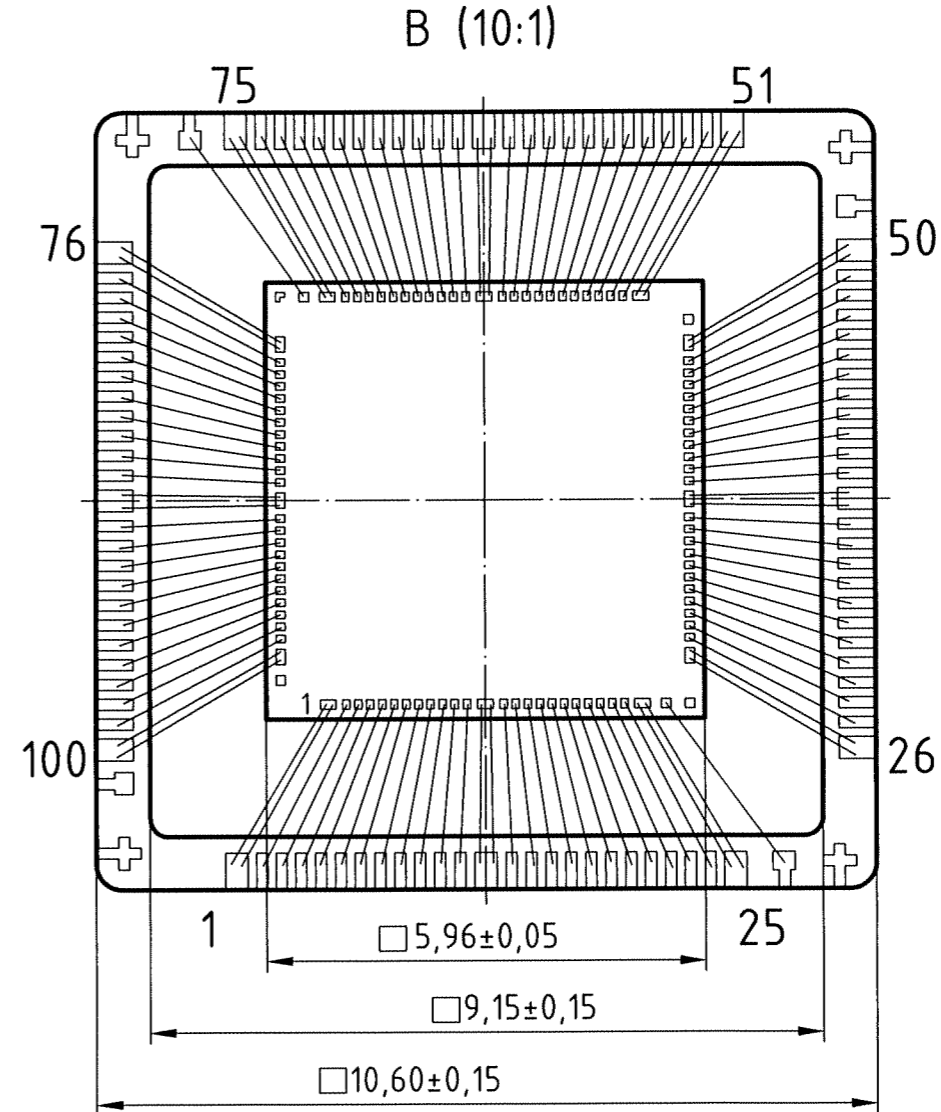
Перв. примен. ГАВЛ.431268.015
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Инв. № подл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата

				ГАВЛ.431268.015СБ		
1	Зам.	ГАВЛ.09-2019		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата		
Разраб.	Астахова					
Пров.	Тикашкин					
512 ВП	Чириченко					
Н.контр.	Казачков					
Утв.	Денисов					
				Микросхемы интегральные		
				5529ТР044, 5529ТР044А		
				Сборочный чертеж		
				Лист 1	Листов 5	

Рис.1 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.015)



Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны

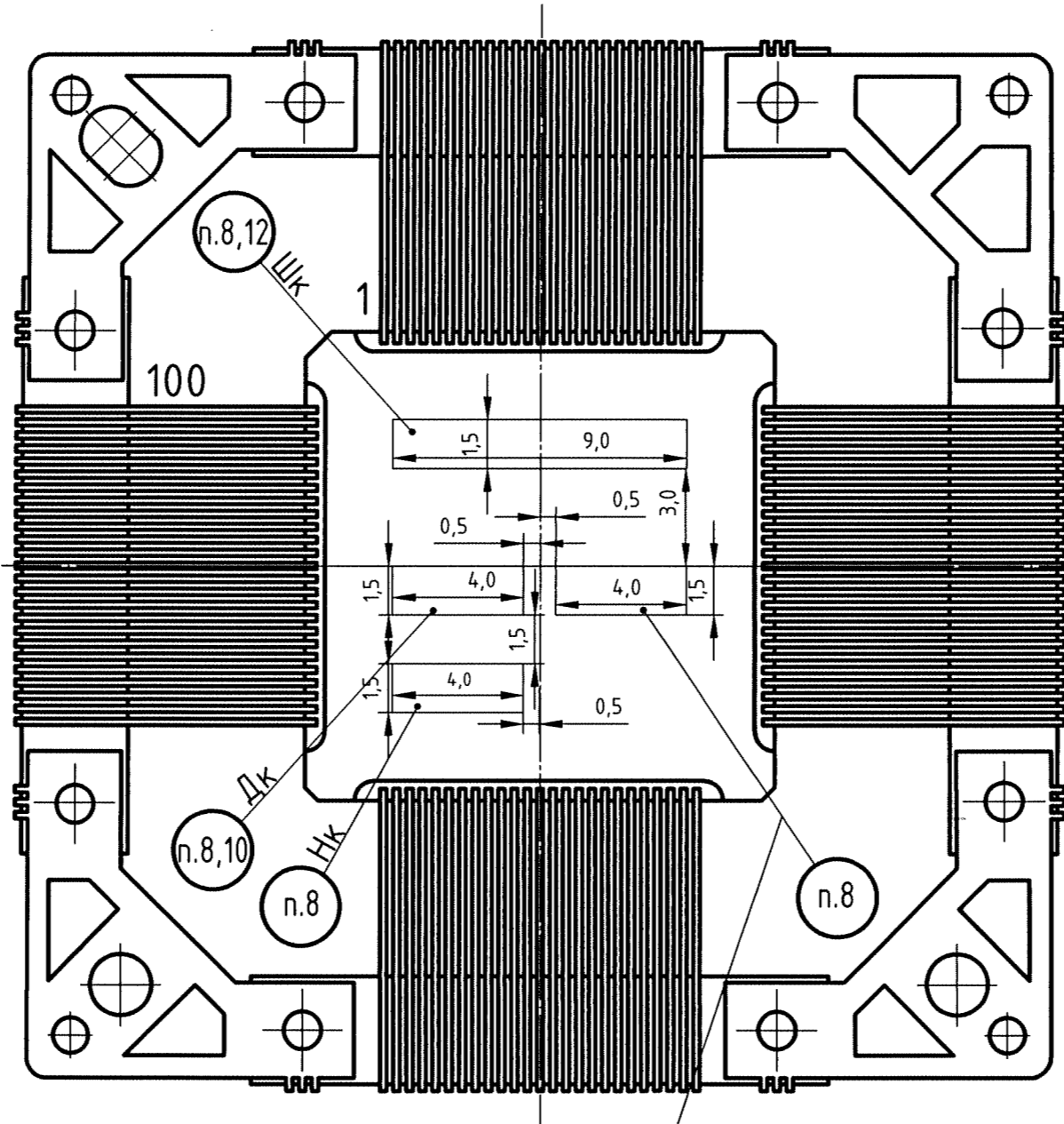


Инв. № подл. 1558	Подп. и дата Лев. 20.01.20	Взам. инв. № Инв. № дубл.	Подп. и дата
----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Лев.	20.01.19
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата

Рис.1 (продолжение)
(ГABЛ.431268.015)

Б (2) ○



Регистрационный
номер карты заказа

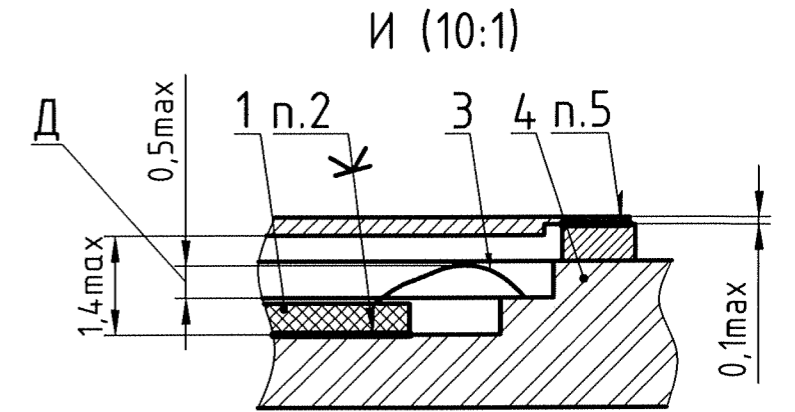
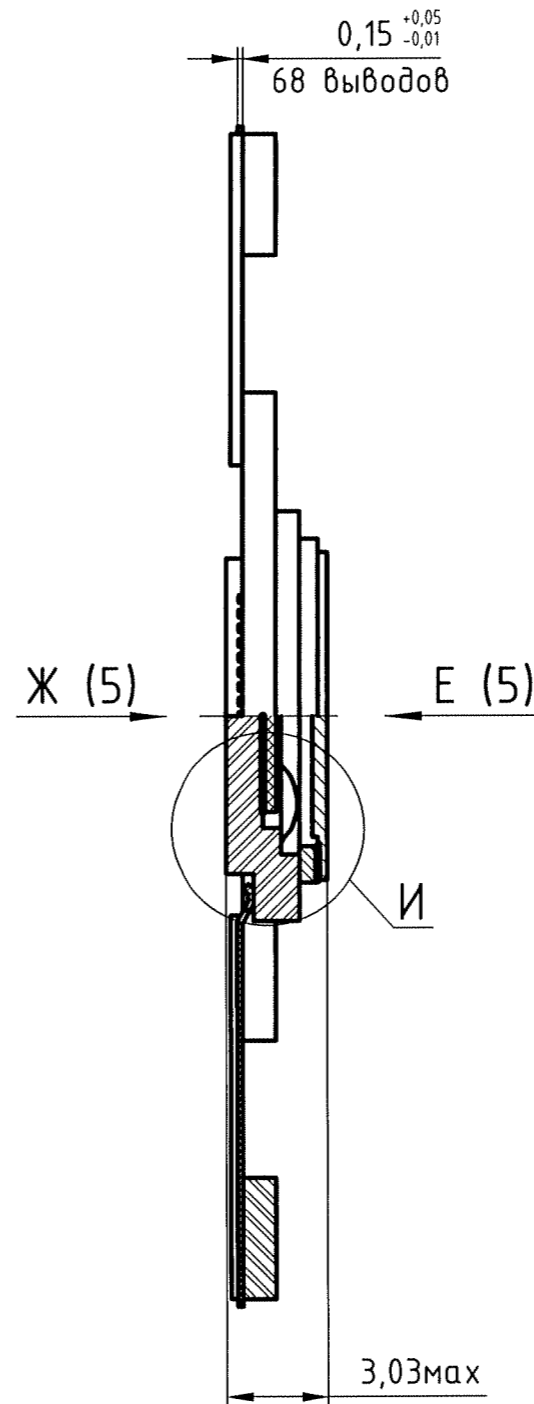
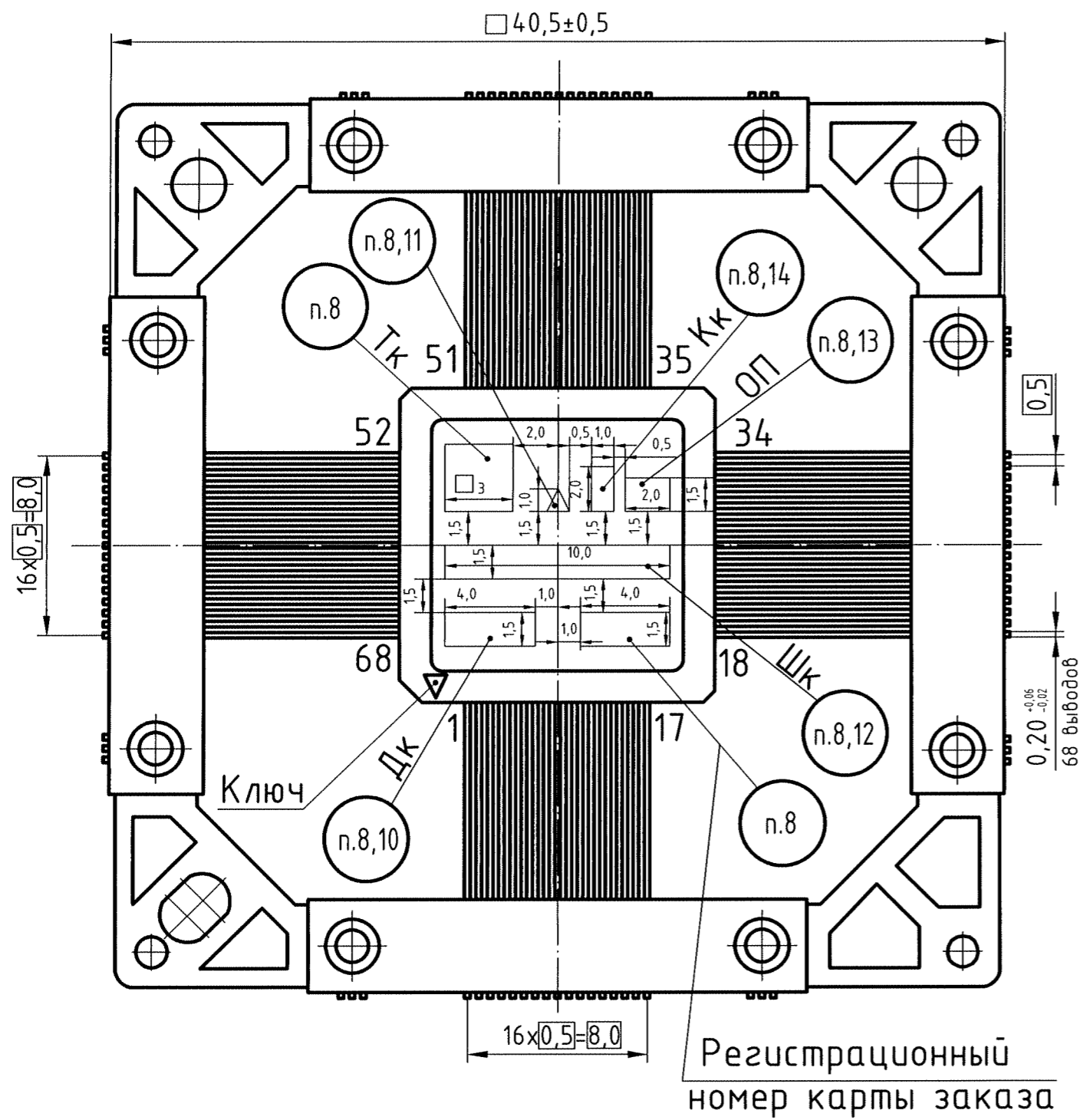
Инв. № подл. 1558	Подп. и дата Сы 20.09.20.	Взам. инв. № Инв. № дцбл	Подп. и дата
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------

1	Зам.	ГABЛ.09-2019	Сы 09.09.19
Изм.	Лист	Докум.	Подп. Дата

ГABЛ.431268.015СБ

Лист
3

Рис.2 (Г АВЛ.431268.015-01)
(см. продолжение на листе 5)



Регистрационный номер карты заказа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1558	Р.А. 20.01.20			

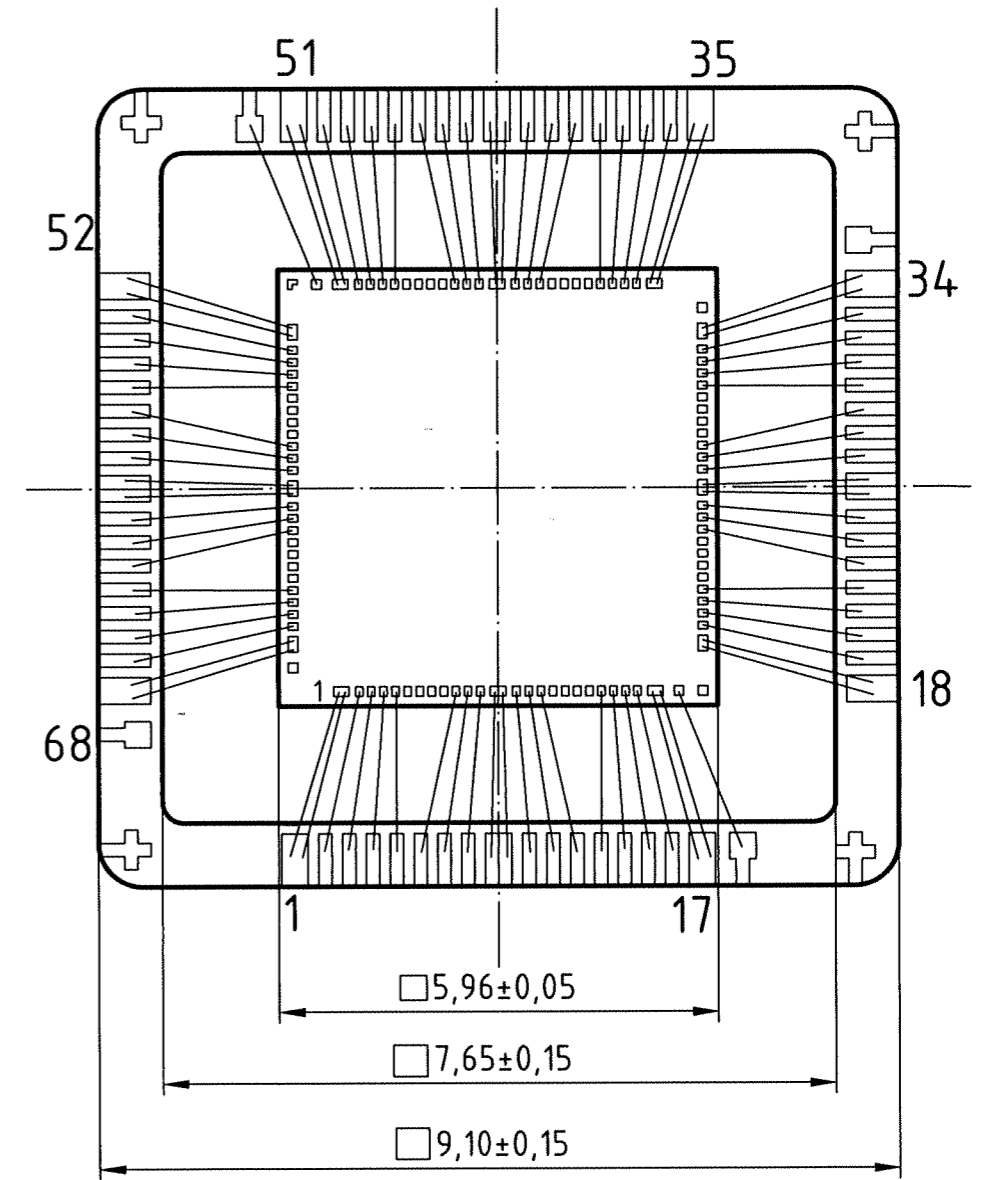
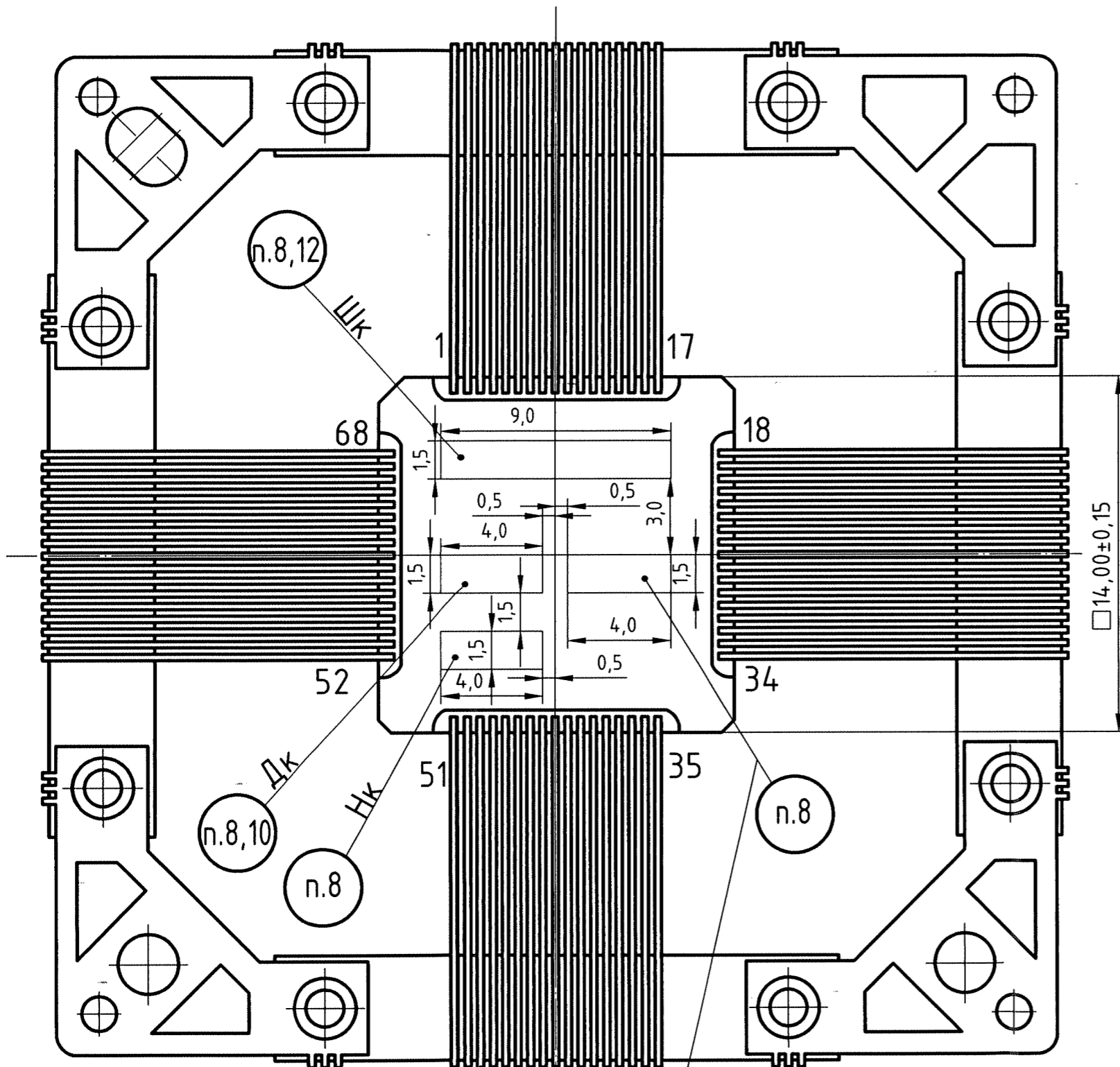
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Р.А. 20.01.20	Г АВЛ.431268.015СБ	Лист
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	4

Рис.2 (продолжение)
(ГВЛ.431268.015-01)

Ж (5:1) (4) ○

Е (10:1) (4)

Крышка и внешние выводы
микросхемы не показаны



Регистрационный
номер карты заказа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1558	20.01.20			

1	Зам.	ГВЛ.09-2019		
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата

ГВЛ.431268.015СБ

Лист
5